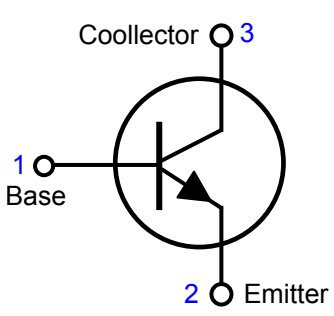
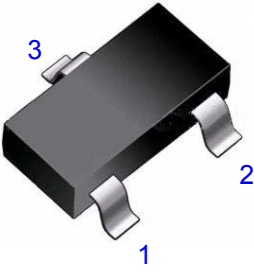



<p>NPN型 小功率 贴片三极管 NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR SMD</p>	<p>HMBT9014 HMBT9014LT1 NPN, BEC General Purpose Transistors</p> <p>对应其他工业型号 S9014 MMBT914 MMBT9014LT1 HMMBT9014LT1</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Excellent hFE linearity</li> <li>■ Low noise</li> <li>■ Complementary to HMBT9015</li> <li>■ Transistor Polarity: NPN</li> <li>■ Transistor pinout: BEC</li> <li>■ SOT-23 Package</li> <li>■ Marking Code: J6</li> <li>■ hFE: 200~450, 450~1000</li> </ul>	

<p>Inner circuit</p>  <p>SOT-23 内部结构</p>	<p>HMBT9014</p>  <p>1. Base 2. Emitter 3. Collector</p> <p>SOT-23 管脚排列</p>	<p>元件标识 (打印)</p>  <p>DEVICE MARKING</p>
--	--	---

■ DEVICE MARKING 元件标识 (打印) 对应放大系数

HMBT9014	L	H
MARKING	J6L	J6H
hFE	200~450	450~1000

■ MAXIMUM RATINGS 最大额定值

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Rating 额定值	Unit 单位
Collector-Base Voltage 集电极-基极电压	$V_{CB0}$	50	V
Collector-Emitter Voltage 集电极-发射极电压	$V_{CEO}$	45	
Emitter-Base Voltage 发射极-基极电压	$V_{EBO}$	5.0	
Collector Current-Continuous 集电极电流-连续	$I_C$	150	mA
Base Current 基极电流	$I_B$	30	
Collector Power Dissipation 集电极耗散功率	$P_C$	225	mW
Junction Temperature 结温	$T_j$	150	°C
Storage Temperature Range 储存温度	$T_{stg}$	-55~+150	



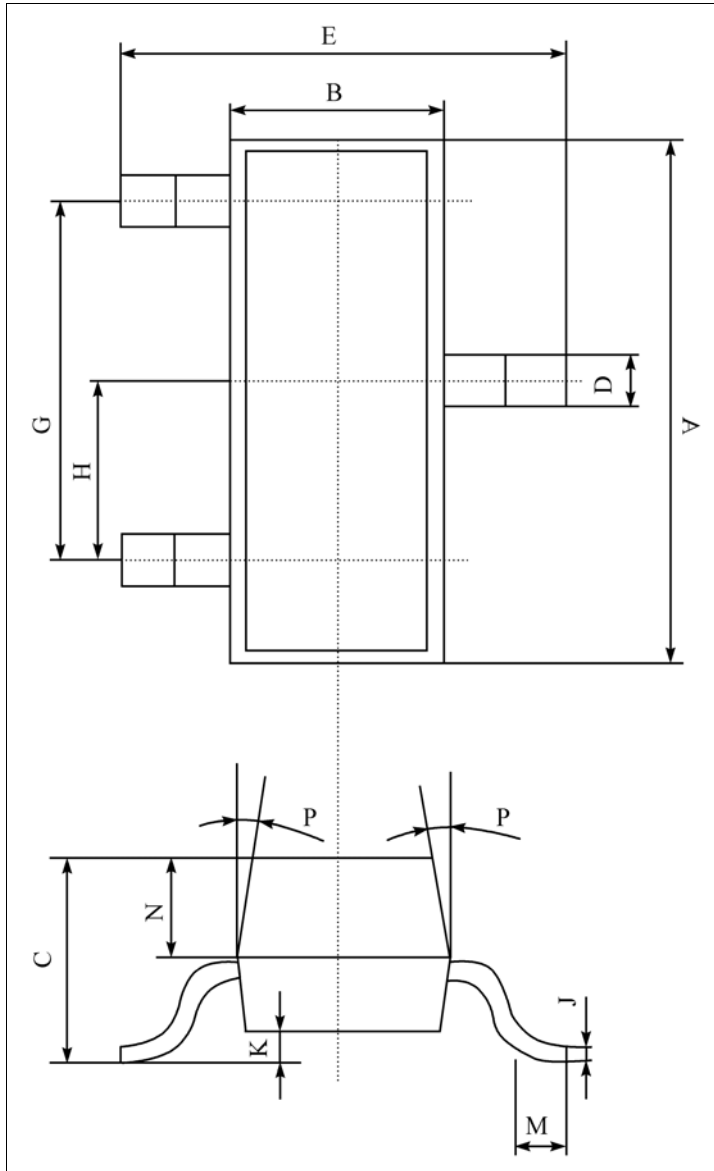
■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电特性 ( $T_A=25^{\circ}\text{C}$  unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为 $25^{\circ}\text{C}$ )

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Test Condition 测试条件	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Unit 单位
Collector Cutoff Current 集电极截止电流	$I_{CBO}$	$I_E=0$ $V_{CB}=50V$	--	--	0.1	$\mu\text{A}$
Emitter Cutoff Current 发射极截止电流	$I_{EBO}$	$I_C=0$ $V_{EB}=5V$	--	--	0.1	
Collector-Base Breakdown Voltage 集电极-基极击穿电压	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=100\mu\text{A}$	50	--	--	V
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集电极-发射极击穿电压	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=1.0\text{mA}$	45	--	--	
Emitter-Base Breakdown Voltage 发射极-基极击穿电压	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=100\mu\text{A}$	5	--	--	
DC Current Gain 直流电流增益	$h_{FE}$	$V_{CE}=6V$ $I_C=2\text{mA}$	200	--	1000	
Collector-Emitter Saturation Voltage 集电极-发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=100\text{mA}$ $I_B=5\text{mA}$	--	--	0.3	V
Base-Emitter Saturation 基极-发射极电压	$V_{BE}$	$V_{CE}=5V$ $I_C=10\text{mA}$	--	--	0.82	
Transition Frequency 特征频率	$f_T$	$V_{CE}=5V$ $I_C=10\text{mA}$	100	180	--	MHz
Collector Output Capacitance 输出电容	$C_{OB}$	$I_E=0$ $V_{CB}=10V$ $f=1\text{MHz}$	--	4.0	7.0	pF

■ DIMENSION 外形封装尺寸数据

Package: SOT-23 HAOHAI Package Code: MM

单位 (UNIT) : mm



序号	数值及公差
A	2.90±0.10
B	1.30±0.10
C	1.00±0.10
D	0.40±0.10
E	2.40±0.20
G	1.90±0.10
H	0.95±0.05
J	0.13±0.05
K	0.00-0.10
M	≥0.20
N	0.60±0.10
P	7±2°

**Packing**  
 SOT-23 包装规格  
 SMD片式表面贴封装  
 包装方式: 载带卷盘包装  
 Tape & Reel, 3Kpcs/Reel  
 每卷数量3000只 (3Kpcs/Reel)  
 每盒数量30000只 (30Kpcs/BOX)  
 每箱数量300000只 (300Kpcs/Cartons)

